

یک ترانزیستور گرافنی ی انعطاف-پذیر

با نشانیدن گرافن و الکترودهای فلزی بر یک زیرلایه ی پلاستیکی، یک ترانزیستور اثر-میدان ی ساخته اند که در برابر خمش و کشش بسیار مقاوم است. این ترانزیستور کرنش ی تا 9%، و نیز تا بیست بار خم-راست-شدن متوالی را تحمل میکند [1]، و مایعات معمولی هم بر آن بی-اثر اند. توان، ضریب تقویت، چگالی ی جریان، و بسامد قطع این ترانزیستور (2.33 GHz) هم بسیار زیاد است.

- [1] <http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/dec/10/flexible-graphene-transistor-sets-new-records>